

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 6 部門第 2 区分
 【発行日】平成 18 年 4 月 6 日 (2006.4.6)

【公開番号】特開 2000-338686 (P2000-338686A)
 【公開日】平成 12 年 12 月 8 日 (2000.12.8)
 【出願番号】特願 平 11-150032
 【国際特許分類】

G 0 3 F 7/42 (2006.01)
H 0 1 L 21/308 (2006.01)
H 0 1 L 21/027 (2006.01)
H 0 1 L 21/302 (2006.01)

【F I】

G 0 3 F 7/42
 H 0 1 L 21/308 Z
 H 0 1 L 21/30 5 7 2 A
 H 0 1 L 21/302 4 0 0

【手続補正書】
 【提出日】平成 18 年 1 月 17 日 (2006.1.17)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】特許請求の範囲
 【補正方法】変更
 【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 硝酸と硫酸および / またはリン酸との水溶液であることを特徴とするサイドウォール除去液。

【請求項 2】 硝酸濃度が 0 . 0 1 重量 % ~ 5 0 重量 % である請求項 1 記載のサイドウォール除去液。

【請求項 3】 硫酸および / またはリン酸濃度が 0 . 0 0 1 ~ 3 0 重量 % である請求項 1 または 2 記載のサイドウォール除去液。

【請求項 4】 請求項 1 ~ 3 のいずれかに記載の液を用いたサイドウォール除去方法。

【請求項 5】 請求項 1 ~ 3 のいずれかに記載の液にサイドウォールが付着した基板を浸漬させ、その後水リンスし、続いて乾燥させるサイドウォール除去方法。

【請求項 6】 半導体製造工程でのドライエッチングの際に発生するサイドウォールを請求項 1 ~ 3 のいずれかに記載のサイドウォール除去液で洗浄する工程を含むことを特徴とするレジストパターンの形成方法。

【請求項 7】 請求項 4 または 5 に記載の方法により洗浄された構造体。